



中华人民共和国国家标准

GB/T 4586—94
IEC 747-8—1984

半导体器件 分立器件 第 8 部分：场效应晶体管

Semiconductor devices Discrete devices
Part 8: Field-effect transistors

1994-12-31 发布

1995-08-01 实施

国家技术监督局 发布

目 次

第 I 章	总则.....	(1)
第 II 章	术语和文字符号.....	(2)
第 III 章	基本额定值和特性.....	(8)
第 IV 章	测试方法.....	(16)
第 V 章	接收和可靠性.....	(38)

中华人民共和国国家标准

半导体器件 分立器件 第8部分:场效应晶体管

GB/T 4586—94
IEC 747-8—1984
代替 GB 4586—84

Semiconductor devices Discrete devices Part 8: Field-effect transistors

本标准等同采用 IEC 747-8—1984《半导体器件 分立器件 第8部分:场效应晶体管》及其 IEC 747-8 第1次更改(1991)。

第 I 章 总 则

1 引言

通常,本标准需要与 IEC 747-1—1983《半导体器件 分立器件和集成电路 第1部分:总则》一起使用。在 IEC 747-1 中,可找到下列的全部基础资料:

- 术语;
- 文字符号;
- 基本额定值和特性;
- 测试方法;
- 接收和可靠性。

各章节编排顺序符合 IEC 747-1 第Ⅲ章 2.1 条的规定。

2 范围

本标准给出了下列类型场效应晶体管的标准:

- A型:结栅型;
- B型:绝缘栅耗尽型;
- C型:绝缘栅增强型。

3 类型

由于场效应晶体管可具有一个或几个栅极,故可分成如下类型:

